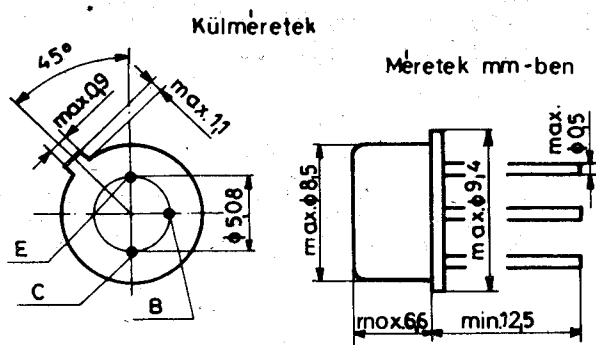


M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT

IV., Fóti út 56.

1325 Budapest, Pf. 21 Telefon: 691-100 Telex: 22-7306

Nagyfeszültségű szilícium NPN planár tranzisztor 2N 3439 2N 3440



Külmeretek

Méreték mm-ben

Tok: TO-39
Tömeg: kb 1,5g

A kollektor a fémházzal
össze van kötve.

Ajánlott alkalmazás

A 2N 3439, 2N 3440 nagyfeszültségű szilícium epitaxiális planár NPN tranzisztor közszükségleti és ipari felhasználásra szolgál. Elsősorban meghajtóként alkalmazható nagyfeszültségű kis áramú inverterekben, kapcsoló és soros üzemű stabilizátorokban.

Bármely alkalmazástechnikai kérdésben a MEV Félvezető Agazat Fejlesztése készséggel áll felhasználóink rendelkezésére (Telefon: 692-800/2337).

Schronk László

MAXIMÁLIS HATÁRADATOK	JELÖLÉS	2N 3439	2N 3440	EGYSÉG
Kollektor-bázis feszültség	V_{CB0}	450	300	V
Kollektor-emitter feszültség	V_{CE0}	350	250	V
Emitter-bázis feszültség	V_{EB0}	7	7	V
Kollektor egyenáram	I_C	1	1	A
Bázis egyenáram	I_B	0,5	0,5	A
TELJES TELJESÍTMÉNYDISSIPÁCIÓ				
$T_{amb} 50^\circ C$	P_{tot}	1	1	W
$T_{case} 25^\circ C$	P_{tot}	10	10	W
Átmeneti hőmérséklet	T_j	150	150	$^\circ C$
Tárolási hőmérséklet	T_s	- 55... +150		$^\circ C$
HŐELLENÁLLÁS				
átmenet és tok között	R_{thjc}	17,5	17,5	K/W
átmenet és környezet között	R_{thja}	150	150	K/W

STATIKUS JELLEMZŐK $T_{case} = 25^\circ C$ ha másként nincs meghatározva	JELÖLÉS	2N 3439	2N 3440	EGYSÉG
Kollektor-bázis visszáram ($I_E = 0$) $V_{CB} = 360V$ $V_{CB} = 250V$	I_{CBO} I_{CBO}	≤ 20	≤ 20	μA μA
Kollektor-emitter visszáram ($I_B = 0$) $V_{CE} = 300V$ $V_{CE} = 200V$	I_{CEO} I_{CEO}	≤ 20	≤ 20	μA μA
Kollektor visszáram ($V_{BE} = -1,5V$) $V_{CE} = 450V$ $V_{CE} = 300V$	I_{CEX} I_{CEX}	≤ 500	≤ 500	μA μA
Emitter-bázis visszáram ($I_C = 0$) $V_{EB} = 6V$	I_{EBO}	≤ 20	≤ 20	μA
Tartós kollektor-emitter feszültség* ($I_B = 0$) $I_C = 50 mA$	$V_{CEO (sus)}$	≥ 350	≥ 250	V
Kollektor-emitter maradék feszültség* $I_C = 50 mA$, $I_B = 4 mA$	V_{CEsat}	$\leq 0,5$	$\leq 0,5$	V
Bázis-emitter maradék feszültség $I_C = 50 mA$, $I_B = 4 mA$	V_{BEsat}	$\leq 1,3$	$\leq 1,3$	V
Egyenáramu áramerősítési tényező* $I_C = 20 mA$, $V_{CE} = 10V$ $I_C = 2 mA$, $V_{CE} = 10V$	h_{21E} h_{21E}	4 ... 160 ≥ 30		

* impulzus üzem: impulzus hossza = 300 μs , kitöltési tényező $\leq 2\%$.

DINAMIKUS JELLEMZŐK $T_{case} = 25^\circ C$	JELÖLÉS	2N 3439	2N 3440	EGYSÉG
Kisjelű áramerősítési tényező $I_C = 5 mA$, $V_{CE} = 10V$, $f = 1 kHz$	h_{21e}	> 25		
Kimenő kapacitás $V_{CB} = 10V$, $f = 1 MHz$	C_{ob}	< 10		pF
Tranzitfrekvencia $I_C = 10 mA$, $V_{CE} = 10V$, $f = 5 MHz$	f_T	> 15		MHz



M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT